
	<h2 style="color: red;">SI7983DP-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI7983DP-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 20V 7.7A PPAK SO-8
	Datenblätter:  SI7983DP-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	


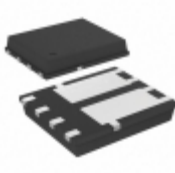
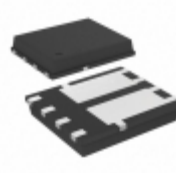
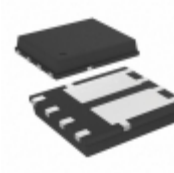
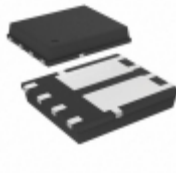

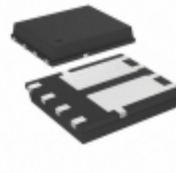
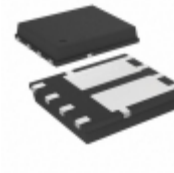
Spezifikationen

Teilenummer	SI7983DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 7.7A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 600µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	17 mOhm @ 12A, 4.5V
Leistung - max	1.4W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	74nC @ 4.5V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 7.7A 1.4W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.7A
Basisteilenummer	SI7983

SI7983DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7983DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7983DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7983DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7997DP-T1-E3 VISHAY VISHAY PAKSO-8</p>	 <p>SI7994DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7980DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 8A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7980DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 8A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7983DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 7.7A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7983DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 7.7A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7983DP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 7.7A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7994DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI7983DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7983DP-T1-GE3 Datenblatt	SI7983DP-T1-GE3-Datenblätter	SI7983DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7983DP-T1-GE3
SI7983DP-T1-GE3 Electronic	SI7983DP-T1-GE3-Komponenten	SI7983DP-T1-GE3-Verteiler	SI7983DP-T1-GE3-Bild	SI7983DP-T1-GE3-Teil
SI7983DP-T1-GE3 Preis	SI7983DP-T1-GE3 Hersteller	SI7983DP-T1-GE3 Bild	SI7983DP-T1-GE3 Aktie	SI7983DP-T1-GE3 Inventar
SI7983DP-T1-GE3 Neu	SI7983DP-T1-GE3 Original	SI7983DP-T1-GE3 garantiert	SI7983DP-T1-GE3 RFQ	SI7983DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited